【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和7年7月14日(2025.7.14)

【国際公開番号】WO2023/003043
【出願番号】特願2023-536795(P2023-536795)
【国際特許分類】
C08G 77/392(2006.01)
C08L 83/10(2006.01)
【ＦＩ】
C08G 77/392
C08L 83/10

【手続補正書】
【提出日】令和7年7月4日(2025.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリシロキサン骨格を主鎖として有するシリコーン系高分子化合物（Ｈ）であって、
前記ポリシロキサン骨格は側鎖に少なくとも一個のホスト基を有し、
前記ホスト基は、シクロデキストリン又はシクロデキストリン誘導体から１個の水素原子又は水酸基が除された１価の基である、シリコーン系高分子化合物。
【請求項２】
ポリシロキサン骨格を主鎖として有するシリコーン系高分子化合物（Ｇ）であって、
前記ポリシロキサン骨格は側鎖に少なくとも一個のゲスト基を有し、
前記ゲスト基は、シクロデキストリン又はシクロデキストリン誘導体に包接可能である基である、シリコーン系高分子化合物。
【請求項３】
ポリシロキサン骨格を主鎖として有するシリコーン系高分子化合物（ＨＧ）であって、前記ポリシロキサン骨格は側鎖に少なくとも一個のホスト基と、少なくとも一個のゲスト基とを有し、
前記ホスト基は、シクロデキストリン又はシクロデキストリン誘導体から１個の水素原子又は水酸基が除された１価の基であり、
前記ゲスト基は、前記シクロデキストリン又はシクロデキストリン誘導体に包接可能である基である、シリコーン系高分子化合物。
【請求項４】
前記ポリシロキサン骨格内のＳｉと前記ホスト基との間にチオエーテル結合を有する、請求項１又は３に記載のシリコーン系高分子化合物。
【請求項５】
請求項１に記載のシリコーン系高分子化合物（Ｈ）と、請求項２に記載のシリコーン系高分子化合物（Ｇ）とを含み、
前記ホスト基は前記ゲスト基を包接している、シリコーン系高分子材料。
【請求項６】
請求項３に記載のシリコーン系高分子化合物（ＨＧ）を含み、
分子間でホスト基及びゲスト基との結合が生じている、シリコーン系高分子材料。
【請求項７】

請求項１に記載のシリコーン系高分子化合物（Ｈ）を含む架橋構造体を備え、
前記架橋構造体は、前記シリコーン系高分子化合物（Ｈ）が有する少なくとも１個の前記ホスト基に他のシリコーン系高分子化合物（Ｈ）の主鎖が貫通した構造を有する、シリコーン系高分子材料。
【請求項８】
さらに鎖状高分子化合物（Ｐ１）を含み、
前記鎖状高分子化合物（Ｐ１）は、前記架橋構造体の網目を貫通している、請求項７に記載のシリコーン系高分子材料。
【請求項９】
請求項１に記載のシリコーン系高分子化合物（Ｈ）及び鎖状高分子化合物（Ｐ１）を含む架橋構造体を備え、
前記架橋構造体は、前記シリコーン系高分子化合物（Ｈ）が有する少なくとも１個の前記ホスト基に前記鎖状高分子化合物（Ｐ１）が貫通した構造を有する、シリコーン系高分子材料。
【請求項１０】
請求項１に記載のシリコーン系高分子化合物（Ｈ）及び該高分子化合物以外の鎖状高分子化合物（Ｐ２）を含み、
前記鎖状高分子化合物（Ｐ２）は側鎖に少なくとも一個のホスト基を有し、前記ホスト基は、シクロデキストリン又はシクロデキストリン誘導体から１個の水素原子又は水酸基が除された１価の基であり、
前記シリコーン系高分子化合物（Ｈ）が有する少なくとも１個の前記ホスト基には、他の高分子化合物（Ｈ）の主鎖が貫通し、
前記鎖状高分子化合物（Ｐ２）が有する少なくとも１個の前記ホスト基には、他の鎖状高分子化合物（Ｐ２）の主鎖が貫通している、シリコーン系高分子材料。
【請求項１１】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシリコーン系高分子化合物を含有する、光学材料。
【請求項１２】
請求項６～１０のいずれか１項に記載のシリコーン系高分子材料を含有する、光学材料。
【請求項１３】
請求項１～３のいずれか１項に記載のシリコーン系高分子化合物の製造方法であって、
ポリシロキサン化合物と、少なくとも１種のアルケニル基含有化合物とを反応する工程を含み、
前記ポリシロキサン化合物は－ＳＨ基及び／又は－Ｓｉ－Ｈ基を有する、シリコーン系高分子化合物の製造方法。